Форма 2.3

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Жақыпова Әлібека Серікұлы на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «6D072300 – Техническая физика»

№ п/п	Название трудов	Рукопись или печатные	Наименование издательства, журнала (№год), № авторского свидетельства	Кол. печ. лист. или стр.	Фамилия соавторов работы
Статьи с импакт-фактором, входящие в международную научную базу данных Scopus и Thomson Reuters					
1	Structural transformation of thin $Ge_2Sb_2Te_5$<Ag> films produced by ion-plasma co-sputtering under laser irradiation	печатное	Journal of Electronic Materials. – 2023. – V. 52(4). – P. 2492-2498. Scopus (CiteScore 2023): 60% WoS (JCR): Impact factor (2023) = 2.2, Q3	7	Prikhodko O.Yu., Ismailova G.A., Kolobov A.V., Turmanova K.N., Nemkaeva R.R., Maksimova S.Ya., Tolepov Zh.K., Peshaya S.L.
2	Thermal stability of the structure and optical properties of nanostructured TiO_2 films	печатное	Russian Physics Journal. – 2021. – V. 63(12). – P. 2045-2051. Scopus (CiteScore 2021): 32% WoS (JCR): Impact factor (2023) = 0.4, Q4	7	Mikhailova S.L., Prikhodko O.Yu., Mukhametkarimov Y.S., Dautkhan K., Doseke U.A., Kozyukhin S.A., Kozik V.V., Ismailova G.A., Maksimova S.Ya., Tarapeyeva A.Yu.
Статьи в изданиях, рекомендуемых КОКСНВО МНВО РК					
3	Влияние примеси Bi на основные параметры вольт-амперных характеристик полупроводника с фазовой памятью $Ge_2Sb_2Te_5$	печатное	Физика и техника полупроводников. – 2024. – Том.58.Вып.8. – С. 443-447 (Список 1)	5	Фефелов С.А., Казаков Л.П., Богословский Н.А., Былев А.Б., Гущина Е.В., Толепов Ж.К., Приходько О.Ю.
4	Изменения структуры наноразмерных аморфных пленок $Ge_2Sb_2Te_5$<Bi> при лазерном облучении	печатное	Вестник Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева. – 2022. – №. 3. – Р. 104-111. (Список 2)	8	Толепов Ж.К., Исмайлова Г.А., Пешая С.Л., Уалханова М.Н.

Соискатель Ә.С. Жақыпов

Ученый секретарь С.Л. Пешая

Форма 2.3

Публикации в трудах международных научных конференций ближнего и дальнего зарубежья					
5	Технология получения наноразмерных пленок $Ge_2Sb_2Te_5$ модифицированных примесью серебра	печатное	Современные проблемы физики конденсированного состояния, нанотехнологий и наноматериалов – Алматы, Казахстан, 17-18 мая, 2018. – С. 175 – 177.	3	Турманова К.Н., Толепов Ж.К., Приходько О.Ю., Исмайлова Г.А., Максимова С.Я.
6	Structure of nanosized $Ge_2Sb_2Te_5$ films with silver impurity	печатное	9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides. – Chisinau, Republic of Moldova, 30 June – 24 July, 2019. – P. 61–62.	2	Turmanova K.N., Prikhodko O.Yu., Tolepov Zh.K., Kozyukhin S., Ismailova G., Maksimova S.
7	Nanoscaled $Ge_2Sb_2Te_5$ films structure transformation influenced by laser irradiation	печатное	The 7th International Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems. – Almaty, Kazakhstan, 7-9 August, 2019. – P. 64.	1	MaksimovaS., Prikhodko O.Yu., Ismailova G.A., Turmanova K.N., Tolepov Zh.K.
8	Production technology and structure of $Ge_2Sb_2Te_5$ nanosized films modified by silver	печатное	Международная научная конференция студентов и молодых ученых «ФАРАБИ ӘЛЕМІ». – Алматы, Казахстан, 6-9 апреля, 2020. – С. 206.	1	Kongilkosheva A.,
9	The features of nanoscaled $Ge_2Sb_2Te_5$ films structure transformation influenced by laser urradiation	печатное	Аморфные и Микрокристаллические плупроводники – Санкт-Петербург, Россия, 5-7 июля, 2021. – С. 99	1	Prikhodko O.Yu., Ismailova G.A., Turmanova K.N., Maksimova S.Ya., Tolepov Zh.K.
10	Effective penetration depth of optical radiation in nanoscaled modified $Ge_2Sb_2Te_5$<Ag> films		The 8th International Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems. – Nur-Sultan, Kazakhstan, 6 August, 2020. – P. 64.	1	Maksimova S.Ya., Prikhodko O.Yu., Ismailova G.A., Turmanova K.N., Tolepov Zh.K.
11	Structure and electronic properties of layered Ge-Sb-Te based alloys	печатное	The 10th International Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems. – Nur-Sultan, Kazakhstan, 4-6 August, 2022. –P. 92.	1	Tolepov Zh.K., Prikhodko O.Yu., Tursyn Ye., Rakhi A.

Соискатель Ә.С. Жақыпов

Ученый секретарь С.Л. Пешая

Форма 2.3

12	Влияние примеси Bi на основные параметры вольт-амперных характеристик тонких плёнок халькогенидного стеклообразного полупроводника $Ge_2Sb_2Te_5$	печатное	Аморфные и Микрокристаллические плупроводники – Санкт-Петербург, Россия, 3-5 июля, 2023. – С. 93-94.	2	Фефелов С.А., Казакова Л.П., Богословский Н.А., Былев А.Б., Гущина Е.В.

Соискатель Ә.С. Жақыпов

Ученый секретарь С.Л. Пешая